电子线路课程设计报 告

课	题

学 号_____

姓 名_____

电子线路课程设计指导

课题一 音频功率放大器

设计任务书

音频功率放大器技术指标

1.最大不失真输出功率

P_{om}≥8W (负载阻抗 R_L=8Ω)

2.输入灵敏度

V_i≤100mv (输入阻抗 R>47KΩ)

3.频率响应

 $f\!\!=\!\!20Hz\!\!\sim\!\!20KHz$

4.噪声电压

 $V_N < 15 \text{mv}(\pm 3 \text{db})$

5.失真度

 $\gamma \leqslant 3\%$

6.音调控制范围

100Hz ± 6 dB 10KHz ± 6 dB

设计报告要求

- 1.各单元电路的工作点电压
- 2.各单元电路的电压增益
- 3.各单元电路幅频特性
- 4.最大输出功率
- 5.系统电路的工作效率

设计基本步骤和方法

设计系统电路的一般方法, 先根据给定的技术指标进行设计方案选择, 然后再安选用的方案进行系统电路设计, 一般步骤为:

- 1. 确定系统电路形式
- 2. 确定放大器级数和各级增益
- 3. 选择晶体管或集成电路等元器件
- 4. 选定各级静态工作点
- 5. 设计计算电路元件参数并选取元件
- 6. 技术指标校核
- 7. 系统电路调试

图(一)所示为音频功率放大器原理图。它由前置放大电路、音调控制电路和功率放大级组成。在进行各部分电路设计计算之前,先确定放大器的级数和各级增益。因给定最大输出功率

$$P_{om} \ge 8W$$

所以输出电压有效值

$$V_0 = \sqrt{P_{\text{om}} \cdot R_L} = 8V \qquad (R_L = 8\Omega)$$

而给定的输入电压

$$V_i \le 100 mV$$

所以放大器总增益

$$A_{vm} = V_0 / V_i$$

$$= \sqrt{P_{om} \cdot R_L / V_i}$$

$$= 8V / 100mV$$

$$= 80$$

考虑到电压放大器倍数应留有充分余量,为了设计计算方便,取 A_{vm}=160,并分配给各级电路:

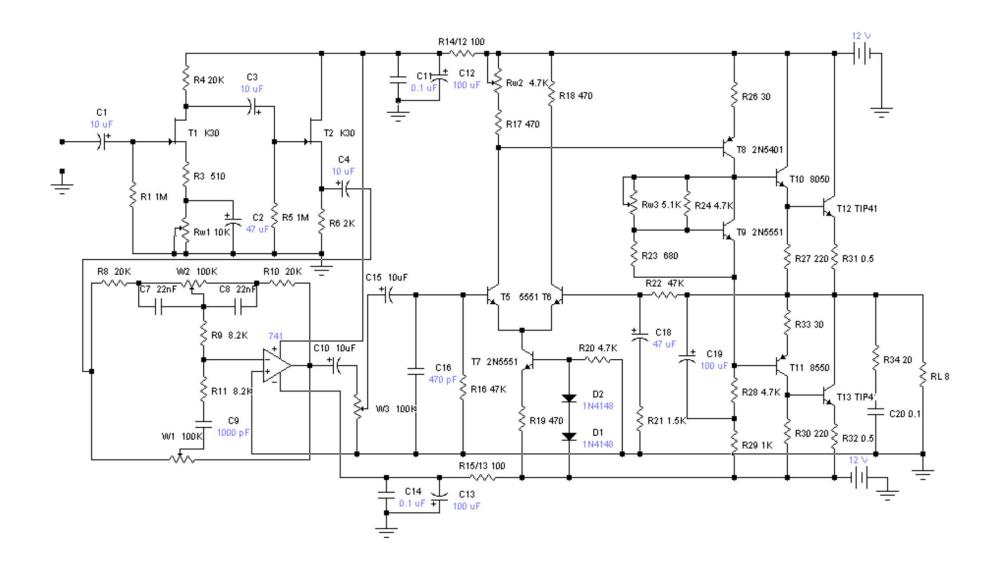
- 1.前置放大器: 因该级对输出的噪声电压影响最大, 故增益不宜太高, 可选 A_{vml}=5~10。
- 2.音调控制电路: 该级无增益要求,可选 A_{vm2}=1。
- 3.功率输出级:输出级电压增益 Avm3 可由

$$A_{vm}=A_{vm1} \cdot A_{vm2} \cdot A_{vm3}$$

得

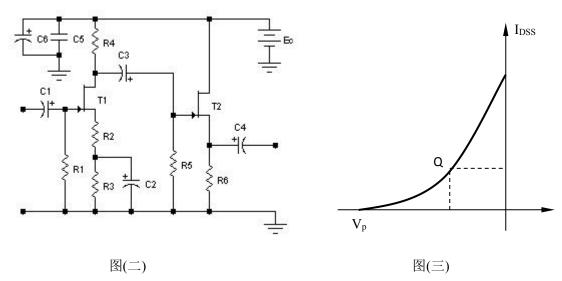
$$A_{vm3}=A_{vm} / A_{vm1} \cdot A_{vm2}$$

=160 / 5×1=32



前置放大器的设计

根据任务书中的指标要求,为了便于与多种信号源匹配,前置放大器须具有较高的输入阻抗,同时,为了使音调控制电路的特性好,前置放大器的输出阻抗要低。另外,由于多级放大器的第一级噪声系数 NF 对总的噪声影响最大,因此,在设计时须考虑采取措施降低前置级的噪声。第一方案可选用场效应管组成本级放大电路,如图(二) 所示为用场效应管共源放大器和源极跟随器组成的该放大电路。第二方案可选用由集成运算放大器构成的同相比例放大器电路。



1.场效应管共源放大器的设计

(1)选择静态工作点

由图(二)可见,该级由 T_1 、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 、 C_1 、 C_2 、 C_3 组成的自给偏压放大器。根据场效应管的转移特性曲线图(三),漏极电流 I_D 随栅极电压 V_{GS} 变化的关系

$$I_{D}=I_{DSS}(1-\frac{V_{GS}}{V_{P}})^{2}$$
 (1)

根据场效应管放大器工作原理,可得

$$V_{GS} = -V_S = -I_D R_S \tag{2}$$

$$V_D = V_{DS} + I_D R_S \tag{3}$$

$$R_{D}=E_{C}-V_{D} \tag{4}$$

选择静态工作点,就是确定电路中的 VGS ID VDS 的数值。

(2) 选择 R_S、R_D

①先由图(三)中选定的 V_{GSQ} 数值代入(1)式, 算得 I_{DQ} 值

$$I_{DQ} = I_{DSS} (1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{P}})^{2}$$

$$R_S = -V_{GSO} / I_{DO}$$

- ③选取 V_{DS} =E/2 或 V_{DS} =(1~2) V_{S} ,并代入(3)式,算得 V_{D}
- ④将 V_D值代入(4)式,算得 R_D

$$R_D = (E-V_D)/I_D$$

(3) 计算电容 C₁、C₂

因为 C₁、C₂主要影响低频响应,要求:

$$C_1 \geqslant (3-10) \frac{1}{2\pi f_L R_1}$$

$$C2 \geqslant \frac{1 + g_m R_2}{2\pi \pi_I R_2}$$

(4)电压增益计算

$$A_{vm_1} = \frac{g_m R_D / / R_L}{1 + g_m R_s}$$

设计举例

现对图(二)电路进行计算。已知放大器输入电压<100mV,输入阻抗 $R_i>470$ K Ω ,输出阻抗 $R_0<1$ K Ω ,频响 20Hz ~50 KHz。

为了保证放大器有足够的动态范围,要求场效应管的 V_P 、 g_m 和 I_{DSS} 值不能太小。 T_1 由使用手册查得参数:

$$V_p = -1V$$
, $g_m = 1.8 \text{ mA} / V$, $I_{DSS} = 5.2 \text{ mA}$.

因为 V_i <100mv,为了减小 NF,所以工作点 Q 选低一些,如图(三)所示,取 V_{GSQ} =0.75V,则 I_{DQ} = I_{DSS} (1- V_{GSQ} / V_P)2 \approx 0.3mA,

若电源电压 E=12V,

则: $V_{DS} \approx E / 2 = 6V$,

V_D=V_{DS}+V_S=6.75V (取 V_S=0.75V)

 $R_D=R_4=(E-V_D)/I_{DQ}\approx 18K \Omega$

 $R_S=R_2+R_3=V_{GSQ} / I_{DQ} \approx 2.5 \text{ K} \Omega$

取: $R_3=2K\Omega$, $R_2=510\Omega$

因 $R_i \approx R_1$ 取 $R_1 = 1$ M Ω

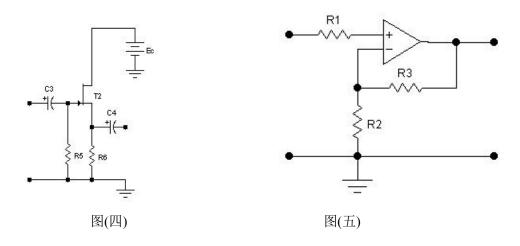
$$C_1 \geqslant \frac{10}{2\pi\pi_I} R_1 \approx 0.8\mu$$
. 取 C_1 =1 μ F (取 f=20Hz)

$$C_2 \! \geqslant \! \frac{1 + g_{_{m}} R_{_{2}}}{2 \pi \pi_{_{\!\!L}} R_{_{2}}} \! pprox \! 18.3 \mu \qquad \mbox{W C}_2 \! = \! 20 \ \mu \ \mbox{F}$$

2.场效应管源极跟随器的设计

为了得到更大的动态跟随范围,一般将工作点选在转移特性曲线的中点,由图(四)可见即

$$\begin{aligned} &V_{GS} \!\!=\!\! V_p \; / \; 2 \\ &I_{DQ} \!\!=\!\! I_{DSS} \; \left[\; 1 \text{-} (V_{GS} \; / \; V_P) \; \right]^{-2} \\ &V_S \!\!=\!\! - \! V_{GS} \\ &R_S \!\!=\!\! V_S \; / \; I_{DQ} \end{aligned}$$

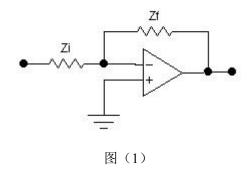


方案二 由图 (五) 所示是一个同相输入放大器,增益为 A_{vm} = $(R_2+R_3)/R_2$

音调控制电路的设计

一、反馈型音调控制电路的工作原理

反馈型音调控制电路如图 1,它主要由两部分组成: ①RC 网络(其中 Z_1 代表输入回路总阻抗, Z_f 代表反馈回路总阻抗),它们可以由电阻、电容串并联构成如图 2 所示的四种不同形式的电路。②放大单元,它可由晶体管、场效应管或线性集成电路构成。因为该电路属于电压并联负反馈形式,当放大单元的开环增益 Au 很高时,则闭环增益

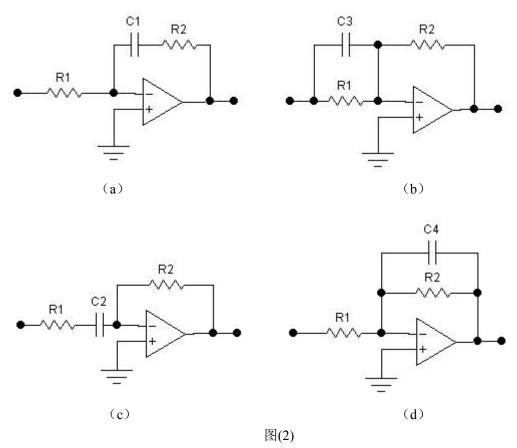


 $A_{uf} = V_O / V_i \approx -Z_f/Z_1$

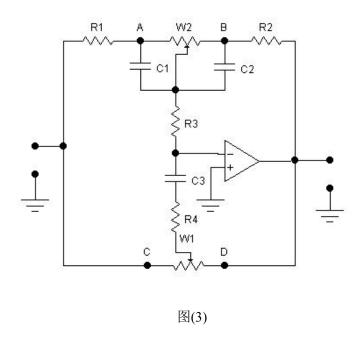
当信号频率不同时, Z_1 和 Z_f 的阻抗值也不同,所以 A_{uf} 随着频率的改变而改变。

如图 2(a),若 C_1 取值较大,只在频率很低时起作用,则当信号频率在低频区, $f \downarrow$ 时,则 $Z_f=R_2+(1/j\omega c_1)\uparrow$, $A_uf=Z_f/R_1\uparrow$,因此可以得到低音提升。再如图 2(b),若 C_3 较小,只有高频时起作用,当信号频率在高频区, $f \uparrow$ 时,则 $Z_1=R_1/(1/j\omega c_3)\downarrow$, $A_uf=Z_f/Z_1\uparrow$,因此可以得到高音提升。

同理,图 2(d)、(c)分别可得到高、低音衰减。



如将四种形式的电路组合起来,即可得到反馈型音调控制电路,如图 3 所示。



为了分析方便, 先假设: R₁=R₂=R₃=R; W₁=W₂=9R; C₁=C₂》C₃。

1.信号在低频区因 C_3 很小, C_3 、 R_4 支路可视为开路,反馈网络主要由上半边起作用,即 V_i 由上半边电路通过。又因为运算放大器开环增益很高,放大器输入阻抗又很高,所以 $V_E \approx V'_E \approx 0$ (虚地),因此 R_3 的影响可以忽略。

①当电位器 V_2 的滑动端移到 A 点时, C_1 被短路,其等效电路如图 4,它和图 2(a)很相似,因此可以得到低音提升。

先分析该电路的幅频特性: 比较图 1 和图 4 可知: $Z_1=R_1$, $Z_1=R_2+C_2/W_2$ 。 所以

$$A_{uf} = -\frac{Z_f}{Z_1} = -\frac{R_2 + W_2}{R_1} \cdot \frac{1 + j\omega \frac{R_2 W_2 C_2}{R_2 + W_2}}{1 + j\omega W_2 \cdot C_2}$$

若设

$$\omega_{L1} = 2\pi f_{L1} = \frac{1}{W_2 C_2}; \omega_{L2} = 2\pi f_{L2} = \frac{R_2 + W_2}{R_2 W_2 C_2}$$

则

$$|A_{\text{uf}}| = \frac{R_2 + W_2}{R_1} \sqrt{\frac{1 + (\frac{\omega}{\omega_{L2}})^2}{1 + (\frac{\omega}{\omega_{L1}})^2}}$$

根据前面假设 $R_1=R_2=R_3=R$; $W_1=W2=9R$; $C_1=C_2$ 》 C_3 可得: $(R_2+W_2)/R_1=10$; $\omega_{L2}/\omega_{L1}=10$ 。 当信号的角频率 $\omega=\omega_{L2}$ 时,

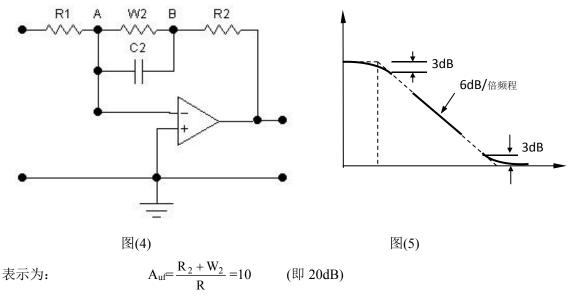
$$|A_{\rm uf}| \approx \frac{R_2 + W_2}{R_1} \sqrt{\frac{1 + (\frac{\omega}{\omega_{\rm L2}})^2}{1 + (\frac{\omega}{\omega_{\rm L1}})^2}} \approx \sqrt{2}$$
 (即 20logA_{uf}=3dB)。

当信号的角频率ω=ωL1时,

$$|A_{uf}| \approx 7.07$$
 ($\mathbb{H} 20 log A_{uf} = 17 dB$).

当 $\omega \geqslant \omega_{L2}$ 时,即信号接近中频时, $|A_{uf}| \approx R_2 + W_2 R_1 \bullet \sqrt{\omega_{L1}/\omega_{L2}} = 1$ (即 $20logA_{uf} = 0dB$)。 当 $\omega \geqslant \omega_{L1}$ 时, $A_uf| \approx 10$ (即 $20logA_{uf} = 20dB$)。

综上所述,可画出图 5 所示的幅频特性。在 $f=f_{L2}$ 或 f_{L1} (提升量为 3dB 和 17dB),曲线变化较大,称 f_{L2} 或 f_{L1} 为转折频率。在两转折频率之间曲线斜率为-6dB / 倍频程。若用折线(图中虚线所示)近似表示此曲线,则 f_{L1} 和 f_{L2} 为折线的拐点。此时,低音最大提`升量为 20dB。



2. 当电位器 W_2 的滑动端移到 B 点时, 其等效电路如图 6 所示。用同样的分析可得图 7

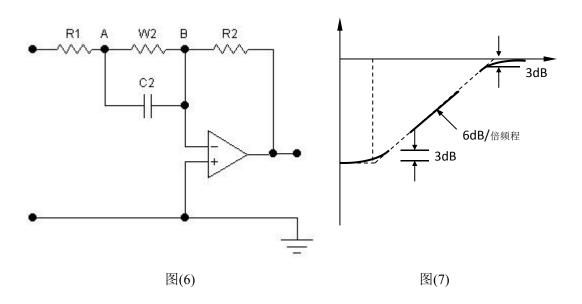
所示低频衰减幅频特性曲线, 其中

$$A_{uf} = \frac{R_2}{R_1 + W_2} \cdot \sqrt{\frac{1 + (\frac{\omega}{\omega_{L1}})^2}{1 + (\frac{\omega}{\omega_{L2}})^2}}$$

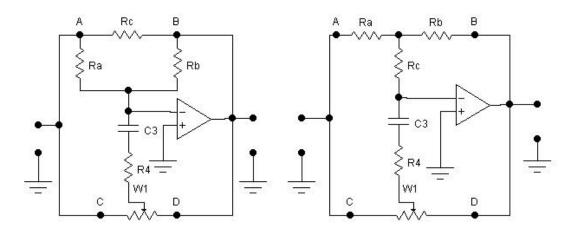
$$\mathbf{f}_{L1}^1 = \frac{1}{2\pi C_1 W_2} = \mathbf{f}_{L1}; \mathbf{f}_{L2}^1 = \frac{R_1 + W_2}{2\pi C_1 W_2 R_1} = \mathbf{f}_{L2}$$

低音最大衰减量为:

$$A_{uc}=R_2 / (R_1+W_2)=1 / 10(BJ-20dB)$$



3.信号在高频区 C_1 和 C_2 对高频可视为短路,此时 C_3 和 R_4 支路已起作用,等效电路可画成图 8 形式。为分析方便将电路中 Y 型接法的 R_1 、 R_2 和 R_3 变换成 Δ 型接法的 R_a 、 R_b 和 R_c ,如图 9 所示,



其中 $R_a=R_1+R_3+\frac{R_1R_3}{R_2}=3R$

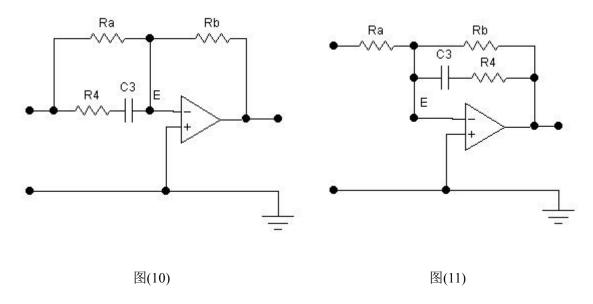
$$R_a = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2} = 3R$$

$$(:R_1 = R_2 = R_3),$$

$$R_b = R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} 3R$$

$$R_c = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} = 3R$$

因为前级输出电阻很小(500 Ω),输出信号 V_0 通过 R,反馈到输入端的信号,被前级输出电阻所旁路,所以 V_c 的影响可以忽略,视为开路。当 W_i 滑动端至 C 和 D 点时,等效电战又可以画成图 10、11 形式(因 W_1 数值很大,亦可视为开路)。



通过幅频特性分析,可得到如下关系式:

高音最大提升量为(图 10 中 C3 短路):

$$A_u T \approx \frac{R_b}{R_a / / R_4} = \frac{R_4 + 3R}{R_4}$$

高频转折频率为:

$$f_{H1} \approx \frac{1}{2\pi C_3 (R_a + R_b)}; f_{H2} = \frac{1}{2\pi C_3 R_4}$$

高音最大衰减量为(图 11 中 C3 短路):

$$A_u T_c \approx \frac{R_b / / R_4}{R_a} = \frac{R_4}{R_4 + 3R}$$

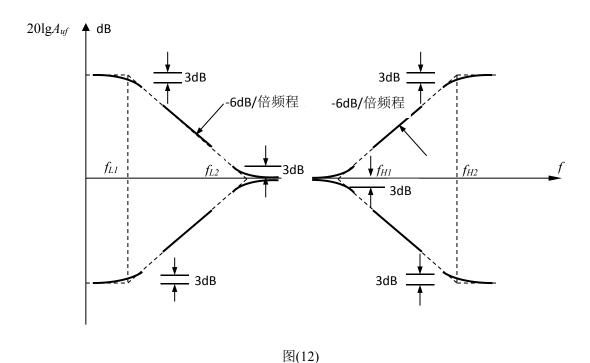
图 12 为音调控制电路全频高低音提升衰减曲线,从曲线可看出在 $f_{L1}\sim f_{L2}$ 和 $f_{H1}\sim f_{H2}$ 之间,曲线按 $\pm 6dB$ 倍频程的斜弯变化,假设给出低频 f_{LX} 处和高频 f_{HX} 处的提升量,可知:

$$f_{L1} < f_{LX} < f_{L2}$$
;

$$f_{H1} < f_{HX} < f_{H2}$$

得: $f_{L2} = f_{LX} \cdot 2 \frac{\frac{B}{2} + \frac{1}{2} (dB)}{6dB}$

$$f_{H1}$$
= f_{HX} • 2 $\frac{提升量(dB)}{6dB}$



上述两个关系式是该电路设计时的计算方法。如已知某一频率的提升量或衰减量时,就可以利用它们求出所需的转折频率及相应元件参数。

二、反馈型音调控制电路的设计方法

音调控制电路元器件参计算步骤如下:

1. 确定转折频率

依据技术指标给出转折频率 f_{H2} , f_{L1} , 以及 f_{LX} 和 f_{HX} 的提升衰减量,于是可算出:

$$f_{L2}\!\!=\!\!f_{LX}$$
・ $2\,rac{\mathrm{提升} \pm (\mathrm{dB})}{6\mathrm{dB}}$; $f_{H1}\!\!=\!\!f_{HX}$ ・ $2\,rac{\mathrm{提升} \pm (\mathrm{dB})}{6\mathrm{dB}}$;

2. 确定 W₁和 W₂的数值和放大单元

若放大单元输入阻抗高, W_1 和 W_2 的阻抗可适当选大些(可选 50K、100K)。通常放大单元的开环增益和输入阻抗要求高些为好(大于 47K)。

3.计算各元件参数

根据式
$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi W_2 C_2}$$
,
可算出 $C_1 = C_2 = \frac{1}{2\pi W_2 f_{L1}}$ 。

根据式
$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi W_2 C_2}$$
 和 $f_{L2} = \frac{W_1 + R_2}{2\pi C_2 W_2 R_2}$

可算出
$$R_2 = \frac{W_2}{(\frac{f_{L1}}{f_{12}} - 1)}$$
,

通常取 $R_1=R_2=R_3$ 。

根据式
$$f_{H2}$$
=1 / 2 π C_3R_4 和 f_{H1} =1 $\frac{1}{2\pi C_3(R_4 + R_a)}$,

可以算出
$$R_4$$
= R_a / $(\frac{f_{H2}}{f_{H1}}$ -1) (可取 R_a = $3R_1$)。

根据式
$$f_{H2} = \frac{1}{2\pi C_3 R_4}$$

可以算出
$$C_3 = \frac{1}{2\pi R_4 f_{H2}}$$
。

三、设计举例

已知,低音 f_{LX} =100Hz 时±12dB;高音 f_{HX} =10KHz 时±12dB,频率响应; f_{LI} =50Hz, f_{H2} =20KHz。

1.选用图 3 所示电路形式, 并根据公式可求得:

$$f_{L2}\!\!=\!\!f_{LX} \bullet 2^{12/6}\!\!=\!\!400 Hz;$$

 $f_{H1} = f_{HX} \cdot 2^{12/6} = 2.5 KHz$.

2.选用线性电位器,并 W_1 = W_2 =100K Ω 。放大单元选用 LM741 集成运算放大器。

3.计算各元件参数

$$C_1 = C_2 = \frac{1}{2\pi W_2 f_{L1}} \approx 0.021 \ \mu F(取 \ 0.022 \ \mu F)$$
。

$$R_1=R_2=rac{W2}{rac{f_{L2}}{f_{L1}}-1}=21K\Omega$$
(按电阻系列取 20K Ω)。

 $R_3=R_1=R_2=20K \Omega$.

$$R_4 = \frac{R_a}{\frac{f_{H2}}{f_{H1}} - 1} = \frac{3R_1}{\frac{f_{H2}}{f_{H1}} - 1} \approx 8.5 \text{K} \Omega (接电阻系列取 8.2 \text{K} \Omega)$$
。

$$C_3 = \frac{1}{2\pi R_4 f_{H2}} \approx 970 pF(接电容系列取 1000 pF)$$
。

4.设计校核

①转折频率:

$$\begin{split} f_{L1} &= \frac{1}{2\pi W_2 C_2} \approx 48 \text{Hz}; \ f_{L2} = \frac{W_2 + W_2}{2\pi C_2 W_2 R_2} \approx 410 \text{Hz}. \\ F_{H1} &= \frac{1}{2\pi C_3 (R_4 + R_a)} \approx 2.3 \text{KH}_2; \ f_{H2} = \frac{1}{2\pi C_3 R_4} \approx 19 \text{KH}_2. \end{split}$$

②提升量:

低音最大提升量:
$$A_{vB} = \frac{R_2 + W_2}{R_1} = 8.5$$
 (18.6dB)。

低音最大衰減量:
$$A_{vc} = \frac{R_2}{R_1 + W_2} = 0.118$$
 (-18.6dB)。

高音最大衰减量:
$$A_{\text{vTC}} = \frac{R_4}{R_4 + 3R} = 0.12$$
 (-18.4dB)。

高音最大提升量:
$$A_{VT} = \frac{R_4 + 3R}{R_4} = 8.3$$
 (18.4dB)。

OCL 放大器设计

图 1 所示为该放大器电路图,分为三个部,即功率输出级、推动级和输入级。功率输出级由 T_{10} 、 T_{12} 、 T_{11} 、 T_{13} 组成的复合管准互补对称电路,以得到较大的输出功率,电阻 R_{31} 、 R_{32} 、 R_{27} 、 R_{30} 用来减小复合管的穿透电流,增加电路的稳定性。偏置电路用 T_9 组在恒压电路,保证功率输出管有合适的初始电流,以克服交越失真。推动级采用 T_8 组成的共射放大电路。为了扩大输出管的动态范围,本级加了自举电容 C_{19} ,在信号负半周,通过 C_{19} 反馈,可为 T_{11} 提供足够的基极电流,保证 T_{11} 、 T_{13} 充分导通。输入级是由 T_5 、 T_6 、 T_7 组成的带恒流源的差分放大电路,减小了直流漂移。由于引入深度直流负反馈,进一步稳定了输出点 A的静态零电压。其反馈系数 $F \approx R_{21} / (R_{21} + R_{22})$,总电压增益 $A_{vf} \approx 1 + R_{22} / R_{21}$ 。

由于电路是多级放大电路,所以它可以遵循下述原则进行设计:由末级开始,从负载要求出发逐级向前设计各有的偏置电路;根据电路安全可靠地工作选择元器件参数;由电压增益确定负反馈电路;由频响确定耦合和旁路电容值。

1. 确定电源电压

为了保证电路安全可靠地工作,通常使电路的最大输出功率 P_{om} 比额定输出功率 P_{o} 要大一些,一般 $P_{om} \approx (1.5 \sim 2) P_{o}$,然后根据 P_{om} 和负载阻抗 R_{L} 计算最大输出电

压
$$V_{om} = \sqrt{2P_{om}R_L}$$
。

考虑到 T_{12} 、 T_{13} 在输出电压最大值时已经接近饱和及发射极电阻 R_{31} 、 R_{32} 上的电压降等 因 素 , 选 择 的 电 源 电 压 E_c 值 必 须 大 于 V_{om} 。 它 们 的 关 系 为 : V_{om} = η E_c , 即 E_c =1 $\frac{1}{n}V_{om}$ = $\frac{1}{n}\sqrt{2P_{om}R_L}$,式中 η 为电源利用效率,一般取 η =0.6 \sim 0.8。

2.估算功率输出级

(1)选择大功率管 T_{12} 、 T_{13} 。根据最大输出功率和电源电压 E_c ,主要考虑三个参数,即晶体管 e_c 结承受的最大反向电压 e_c 集电极最大电流 e_c e_c

因为 T_{12} 、 T_{13} 随受的最大反压 $V_{CEmax} \approx 2Ec$;每只管子最大集电极电流(忽略管压降) $I_{cl2max} \approx Ec$ / ($R_L + R_{31}$);单管最大集功耗 $P_{cl2max} \approx 0.2P_{om} + I_OE_c$ (乙类电路管耗最大值 P_{CM} 发生在最大输出功率的 0.4 倍时,两个管耗的最大值为 $0.4P_{om}$,则单管管耗为 $0.2P_{om}$)。所以选择 T_{12} 、 T_{13} 时其极参数应满足: $BV_{CEO} > V_{CEmax}$; $I_{CM} > I_{cl2max}$; $P_{CM} > P_{cl2max}$ 。并使两管 $\beta_{12} \approx \beta_{13}$,参数尽量对称。还要根据环境温度采取必要的散热措施。

(2)选择 T_{10} 、 T_{11} 估算 R_{27} 、 R_{30} 和 R_{34} 。确定 R_{27} 、 R_{30} 的原则是: 应使 T_{10} 、 T_{11} 的输出电流大部分发能注入 T_{12} 、 T_{13} 的基极。因为 T_{12} 、 T_{13} 参数对称,所以基极回路的输入电阻 $T_{112}=T_{113}$,通常取 $R_{27}=R_{30}=(5\sim10)T_{112}$ 。

其中 r_{i12} = r_{be12} + $(1+β_{12})R_{31}$; r_{i13} = r_{be13} + $(1+β_{13})R_{32}$,大功率管 r_{be12} 、 r_{be13} 一般为 10Ω左右。

 r_{34} 为平衡电阻。因为 T_{10} 和 T_{11} 分别为 NPN 与 PNP 两种管型,电路接法也不相同,所以两管输入阻抗也不相等,会使加在两管基极的输入信号不对称,产生失真。为此,需加平衡电阻 R_{34} ,以尽量保证两复合管输入电阻相等,一般要求: R_{34} = R_{27} // r_{i12} 。

因为 T_{10} 、 T_{11} 分别与 T_{12} 和 T_{13} 复合,它们承受的最大反压相同,均为 $2E_c$ 。而在计算集电极最大电流和最大管耗时,还要考虑到 R_{27} 、 R_{30} 的分流作用和晶体管内部造成的损耗。所以在工程计算中可近似认为:

$$I_{c10max} = I_{c11max} \approx (1.1 \sim 1.5)I_{c12max} / \beta_{12}$$

 $P_{c10max} = I_{c11max} \approx (1.1 \sim 1.5)P_{c12max} / \beta_{12}$

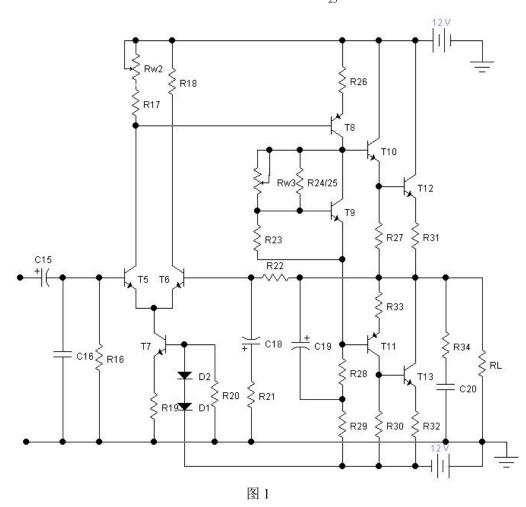
因此, T₁₀、T₁₁的极限参数选择原则是:

$$\begin{aligned} BV_{CEO} \!\! > \!\! 2E_c \\ I_{CM} \!\! > \!\! (1.1 \!\! \sim \!\! 1.5)I_{c12max} \, / \, \beta_{12} \\ P_{CM} \!\! > \!\! (1.1 \!\! \sim \!\! 1.5)P_{c12max} \, / \, \beta_{12} \end{aligned}$$

 T_{10} 为 NPN 管, T_{12} 为 PNP 管,并使 $\beta_{10} \approx \beta_{11}$ 。

(3)计算偏置电路,确定 R_{23} 、 R_{24} 、 R_{25} 并选择 T_9 。 R_{23} 、 R_{24} 、 R_{25} 与 T_9 组成了功率输出级的偏置电路,通常称为"VBE 扩大电路"。它利用 T_9 管的 TBE 基本上为一固定值(硅管为 0.7V 左右)的现象,当电阻 R_{24} // 的 R_{25} 跨接在它的三个电极时,只要流过电阻的电流远大于基极电流 I_{B9} ,我们就可以利用这两个电阻的阻值比来得到某一个近似固定的偏压,因为 V_{B10} 、 V_{B11} 分别为 T_{10} 、 T_{11} 的基极电位,又 V_{BE10} = V_{BE12} = V_{BE11} | ≈ 0.7 V,则 V_{B10} - V_{B11} ≈ 2.1 V,故

$$V_{CE9} = V_{B10} - V_{B11} \approx V_{BE9} \cdot \frac{R_{24} / (R_{25} + R_{23})}{R_{23}}$$



设 V_{BE9} =0.7V,可得 R_{24} // R_{25} =2 R_{23} ,而 R_{23} \approx V_{BE9} / I_{R23} \approx (5 \sim 10) I_{CQ9} / β 9,以保证 T_9 基极电位稳定)。为了便于调节偏置电压的数值,取 R_{24} 为一固定电阻, R_{25} 为一可调电阻。

3.估算推动级电路

- (1)确定 T_8 的工作电流。推动级要有足够的电流输出给功率输出级。为了保证信号不失真, T_8 必须工作在甲类放大状态,通常要求: $I_{CQ8}{\geqslant}3I_{B10max}{\approx}3I_{c10max}{\approx}3I_{c10max}/$ β_{10} ,一般取 $I_{CQ8}{\approx}2{\sim}10mA$ 。
- (2)确定 R_{28} 、 R_{29} 。因为 $(R_{28}+R_{29})$ 是 T_8 的直流负载,而 V_{B11} \approx -0.7V,所以 $R_{28}+R_{29}=(E_c-V_{B11})$ / I_{CQ8} 。从交流通路看, R_{29} 实际与负载 R_L 并联,其阻抗太小会损耗信号输出功率,太大必

然使 R_{28} 减小,而 R_{28} 为共射电路有效负载,其值太小将会使推动级的增益下降,因此一般取: $(R_{28}+R_{29})/3 > R_{9} > R_{L}$ 。确定了 R_{29} 就可求出 R_{28} 。

(3)确定 C_{19} 。为了在最低工作频率时其容抗远小于 R_{29} ,一般取 C_{19} ≈(3 \sim 10)1 / 2 π $f_L R_{29}$ 。 (4)选择 T_8 管。因 T_8 工作在甲类放大状态,一般要求: BV_{CEO} > V_{CEBmax} =2 E_c (最大反向电压); P_{CM} >> $E_c I_{CO8}$ (一般取 $5E_c \cdot I_{CO8}$)。

4.估算输入级电路

- (1)确定差分管工作电流。因为差管 T_5 、 T_6 的集电极电流太大,会增加管耗和噪声,使失调电压和漂移增大;太小又会降低电路的开环增益,所以一般选择: $I_{c5} \approx I_{c6} \approx (0.5 \sim 2) mA$,则 $I_{c5} + I_{c6}$ 。
- (2)确定 R_{17} 、 R_{18} 、 R_{19} 、 R_{20} 。 R_{17} + R_{18} = V_{BE8} / I_{c5} (若不加 R_{26} 、, V_{BE8} \approx 0.7V)。 T_7 为恒流源,为使其工作点稳定应使流过 D_1 、 D_2 的电流(I_D 》 I_{C7} / β_7),又由于利用 D_1 、 D_2 正向导通时的稳压特性来稳定 Q 点。要使 2CP 型二极管有较好的稳定效果, I_D 需在 3mA 以上,因此一般取 $I_D \geq 3mA$,由图 1 可直接求出: R_{20} = $\left[|E_C| V_{D1} + V_{D2} \right]$ / I_D (其中 V_{D1} = V_{D2} \approx 0.7V)。 R_{19} = $\left(V_{D1} + V_{D2} V_{BE7} \right)$ / I_{C7} 。
- (3)选择 T_5 、 T_6 、 T_7 管。为了使差分放大电路稳定可靠地工作,要求 T_5 、 T_6 满足: $BV_{CEO} > 1.2E_c$; $P_{CM} > 5P_c(I_{CS} \cdot E_c)$,并使 $\beta_5 = 6$ 。 T_7 亦可选同类的晶体管。

5.计算反馈支路

差分放大器电路引入了电压串联负反馈,使输入级的输入电阻提高,因此基极电阻 R_{16} 对该级输入阻抗影响很大,一般骤 R_{16} =15~47K Ω 。为了保证直流平衡,选 R_{16} = R_{22} 。又因为功率放大电路的总电压增益 A_{rr} ≈1+(R_{22} / R_{21}),所以 R_{21} = R_{22} / (A_{rf} -1)。另外 C_{18} 应保证在低频截止频率时,其容抗远小于 R_{21} ,一般取 C_{18} \geq (3~10) 1 / 2 π f_LR_{21} 。耦合电容 C_{15} 一般取 C_{15} \geq (3~10) 1 / 2 π f_LR_{26} 。

6.补偿元件的选取

为了使负载在高频时仍为纯电阻,需加补偿电阻 R_{33} 和补偿电容 $\geq C_{20}$ 。一般取 $R_{33}=R_L,C_{20}=1$ / 2π $f_HR_{33}(f_H$ 为放大器上限频率)。此外,为了消除高频自激,通常在 T_8 和 bc 之间, R_{16} 两端加消振电容,一般取 $100\sim200 pF$ 。

设计举例

已知:要求最大输出功率 $P_{om} \ge 8W$;负载阻抗 $R_L = 8\Omega$;电压放大倍数 $A_{vf} = 30$;失真度 $v \le 3\%$ 。现计算如下:

1.选择图 1 所示电路

2.确定电源电压

 E_c =1 / η $\overline{)2P_{om}R_L}$ \approx 14V(取 η =0.8),选定电源电压±15V。

3选 T₁₂、T₁₃

要求 BV_{CEO}>2E_C=30V; I_{CM} > I_{c12max} ≈ E_c / (R_L + R_{31})≈ E_c / R_L ≈1.88A; P_{CM} > P_{c12max} ≈0.2 P_{om} + E_c • I_{O} ,取功率管静态电流 I_{O} =20mA,则 P_{CM} >1.9W。 按以上参数选得 TIP41,测得 β I_{12} = β I_{3} =60。

4.选择 T₁₀、T₁₁估算 R₃₁、R₂₇、R₃₀、R₃₄。

- (1)要求 T_{10} 、 T_{11} 管 $BV_{CEO}>30V$; $I_{CM}>1.5I_{c12max}$ / $\beta_{12}\approx48mW$ 。选 T_{10} 为 2SC8050, T_{11} 为 2SC8550,测得 $\beta_{10}=\beta_{11}=60$ 。
- (2)据 R_{31} = R_{32} = $(0.05\sim0.1)R_L$,选 R_{31} = R_{32} = $0.5\,\Omega$ 电阻,可用电子线绕制,功率大于 1W。 因为 r_{i12} = r_{bc12} + $(1+\beta_{12})R_{31}$ = $40.5\,\Omega$,所以 R_{27} = R_{30} = $5r_{i12}$ = $202.5\,\Omega$,取 R_{27} = R_{30} = $220\,\Omega$ 。因 R_{34} = R_{27} // r_{i12} \approx 34 Ω ,所以取 R_{34} 为 $30\,\Omega$ 。

5.估算推动级电路

- (1)取 $I_{CO8}=3I_{c10max}$ / $\beta_{10}=3\times47$ / $60\approx2.4mA$ 。
- (2)估算 T_9 偏置电路。选取 T_9 为 2SC9013,测得 β_9 =60,取 I_{R33} =1mA (此时 I_{R33} 》 I_{C19} / β_9 ,保证了 T_9 基极电位稳定),则 R_{23} \approx V_{BE9} / I_{R23} \approx 0.7V / ImA=700 Ω 。
- (此时 I_{R33}) I_{C1}9 / β 9,保证了 T9基极电位稳定),则 R₂₃ ~ V_{BE9} / I_{R23} ~ 0.7V / ImA=700 Ω 。 又 R₂₄ // R₂₅=2R₂₃=1.36K Ω,以 R₂₄=2.7K Ω 半可调电阻。
- (3)估算 R_{28} 、 R_{29} 。因为 $R_{28}+R_{29}$ \approx (E_c-V_{BEII})/ I_{CQ8} \approx (15-0.7) / 2.4 \approx 5.96K Ω ,又要求 2K Ω > R_{29} > $160 <math>\Omega$,所以取 R_{29} = 1K Ω , R_{28} = 4.7K Ω (注: R_{28} 为共射电路交流有效负载,其值太小会使推动级的增益下降,从而使最大输出功率减小。因此,若输出功率达不到技术指标,可适当增大 R_{28} 的取值)。
- (4)选 T_8 管。要求 $P_{CM}>5E_cI_{CQ8}=180W$; $BV_{CEC}>2E_c=30V$,选择小功率 PNP 型管可满足要求。

6.自举电路

7.估算输入级

- (1)取差分管工作电流 $I_{c5}=I_{c6}=0.8$ mA,则 $I_{c7}=2\times I_{c5}=1.6$ mA。
- (2)估算 R_{17} 、 R_{18} 、 R_{19} 、 R_{20} 。一般取 $R_{17}+R_{18}=|V_{BE8}|$ / $I_{c5}=875\,\Omega$ (取 $R_{7}=470\,\Omega$, R_{18} 可用 $1K\,\Omega$ 可调电位器,调节时应使 R_{18} 由小向大)。另外,为了防止在调节 R_{18} 时 T_8 电流过大烧毁晶体管,可以在 T_8 射极串一电阻 R_{26} ,此时推动稳定性提高了,但增益会有下降。接入 R_{26} 后,应用下式计算:

$$R_{17}$$
+ R_{18} = $|V_{BE8}|$ + I_{E8} • R_{26} / I_{c5}
 R_{19} = $\left[(V_{D1}+V_{D2})-V_{BE7}\right]$ / I_{c7} =440 Ω (與 470 Ω)
 R_{20} = $\left[E_c$ - $\left(V_{D1}+V_{D2}\right)\right]$ / I_D $\left[15$ - $\left(0.7+0.7\right)\right]$ / 3.12
=4.36K Ω (與 4.3K Ω)

(3)选择 T₅、T₆和 T₇管。要求 T₅、T₆满足 BV_{CEO}>1.2E_c=18V, P_{CM}≥5P_{c5}=5P_{c5}=5 P_{c6} =5E_c • I_{c5}=60mW; β₅=β₆≥50,且反向电流小,例如,选择小功率 NPN 型管。T₇亦可选用同类型管。

8.计算反馈支路

即 R_{16} = R_{22} =47K Ω 。 因为 A_{rf} =32,所以 R_{22} / A_{rf} -1 \approx 1.5K Ω (取 1.5K Ω). C_{18} \geqslant 10 / 2 π f_LR_{21} \approx 33 μ F (取 f_L =20Hz, C_{18} =47 μ F); C_{15} \geqslant 10 / 2 π f_LR_{16} \approx 1.7 μ F (取 C_{15} =10 μ F)。

9.计算补偿元件

取 R_{33} =20 Ω ; C_{20} =1 / 2 π $f_L R_{33} \approx 0.4 \mu$ F(取 f_H =20KHz),通常取 C_{20} =0.1 μ F 即可, C_{16} = C_{17} =100pF。附录一所示完整的设计结果。

